

一般項目	最大定格		電 気 的 特 性				備 考	ピ ン 接 続 図	
	項 目	定 格 値	項 目	最 小	標 準	最 大			測 定 条 件
●2SC5086 東芝 用途: VHF/UHF 低雑音増幅用。 特長: 雑音特性に優れる。	$V_{CE0}(V)$	12	$I_{CBO}(\mu A)$			1.00	$V_{CB}=10V, I_E=0$	hFE分類: 0:80~160, Y:120~240 表示マーク: M	 (上面)
	$V_{EBO}(V)$	3	hFE	80.00		240.00	$V_{CE}=5V, I_C=10mA$		
	$I_C(mA)$	30	$f_T(GHz)$	5.00	7.00		$V_{CE}=5V, I_C=10mA$		
	$P_C(mW)$	100	$C_{re}(pF)$		0.45	0.90	$V_{CB}=5V, I_E=0, f=1MHz$		
	$T_j(^{\circ}C)$	125	$ S_{21e} ^2(dB)$	8.50	12.00		$V_{CE}=5V, I_C=10mA, 1GHz$		
			NF(dB)		1.10	2.00	$V_{CE}=5V, I_C=3mA, f=1GHz$		
●HN3C01F 東芝 用途: VHF TV チューナ周波数変換, VHF 帯高周波増幅用 特長: f_T が高く, 電流依存性が優れている。帰還容量が小さい。パッケージ内に2素子を内蔵。	$V_{CE0}(V)$	20	$I_{CBO}(\mu A)$			0.10	$V_{CB}=25V, I_E=0$	現品表示: WA (Q1) (Q2)	 (上面)
	$V_{EBO}(V)$	3	hFE	40.00	150.00	300.00	$V_{CE}=10V, I_C=5mA$		
	$I_C(mA)$	50	$f_T(GHz)$	0.90	1.40		$V_{CE}=10V, I_C=5mA$		
	$P_C(mW)*$	300	$C_{re1}(pF)$		0.38	0.55	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		
	$T_j(^{\circ}C)$	125	$C_{re2}(pF)$		0.31	0.50	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		
	*トータル定格								
●HN3C02F 東芝 用途: UHF TV チューナ周波数変換, UHF 帯高周波増幅用 特長: f_T が高く, 電流依存性が優れている。帰還容量が小さい。パッケージ内に2素子を内蔵。	$V_{CE0}(V)$	15	$I_{CBO}(\mu A)$			0.10	$V_{CB}=30V, I_E=0$	現品表示: WB (Q1) (Q2)	 (上面)
	$V_{EBO}(V)$	3	hFE	40.00	100.00	200.00	$V_{CE}=10V, I_C=5mA$		
	$I_C(mA)$	50	$f_T(GHz)$	1.50	2.40		$V_{CE}=10V, I_C=2mA$		
	$P_C(mW)*$	300	$C_{re1}(pF)$		0.53	0.85	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		
	$T_j(^{\circ}C)$	125	$C_{re2}(pF)$		0.48	0.80	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		
	*トータル定格								
●HN3C03F 東芝 用途: UHF TV チューナ共振用 (コネクタ接地) 特長: f_T が高く, 電流依存性が優れている。パッケージ内に2素子を内蔵。	$V_{CE0}(V)$	12	$I_{CBO}(\mu A)$			0.10	$V_{CB}=10V, I_E=0$	現品表示: WC (Q1) (Q2)	 (上面)
	$V_{EBO}(V)$	3	hFE	35.00		130.00	$V_{CE}=10V, I_C=5mA$		
	$I_C(mA)$	30	$f_T(GHz)$	2.60	4.00		$V_{CE}=10V, I_C=10mA, 1GHz$		
	$P_C(mW)*$	300	$C_{re1}(pF)$		1.20	1.55	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		
	$T_j(^{\circ}C)$	125	$C_{re2}(pF)$		1.00	1.35	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		
	*トータル定格								
●HN3C06F 東芝 用途: VHF/UHF 低雑音増幅用 特長: 雑音特性が優れている。	$V_{CE0}(V)$	12	$I_{CBO}(\mu A)$			1.00	$V_{CB}=10V, I_E=0$	現品表示: WE (Q1), *f=500MHz (Q2)	 (上面)
	$V_{EBO}(V)$	3	hFE	30.00		250.00	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$		
	$I_C(mA)$	80	$f_T(GHz)$	5.00	7.00		$V_{CE}=10V, I_C=20mA$		
	$P_C(mW)*$	300	NF1(dB)		1.00		$V_{CE}=10V, I_C=5mA, *$		
	$T_j(^{\circ}C)$	125	NF2(dB)		1.10	2.00	$V_{CE}=10V, I_C=5mA, 1GHz$		
	*トータル定格		$ S_{21e} ^2(dB)$		12.00				